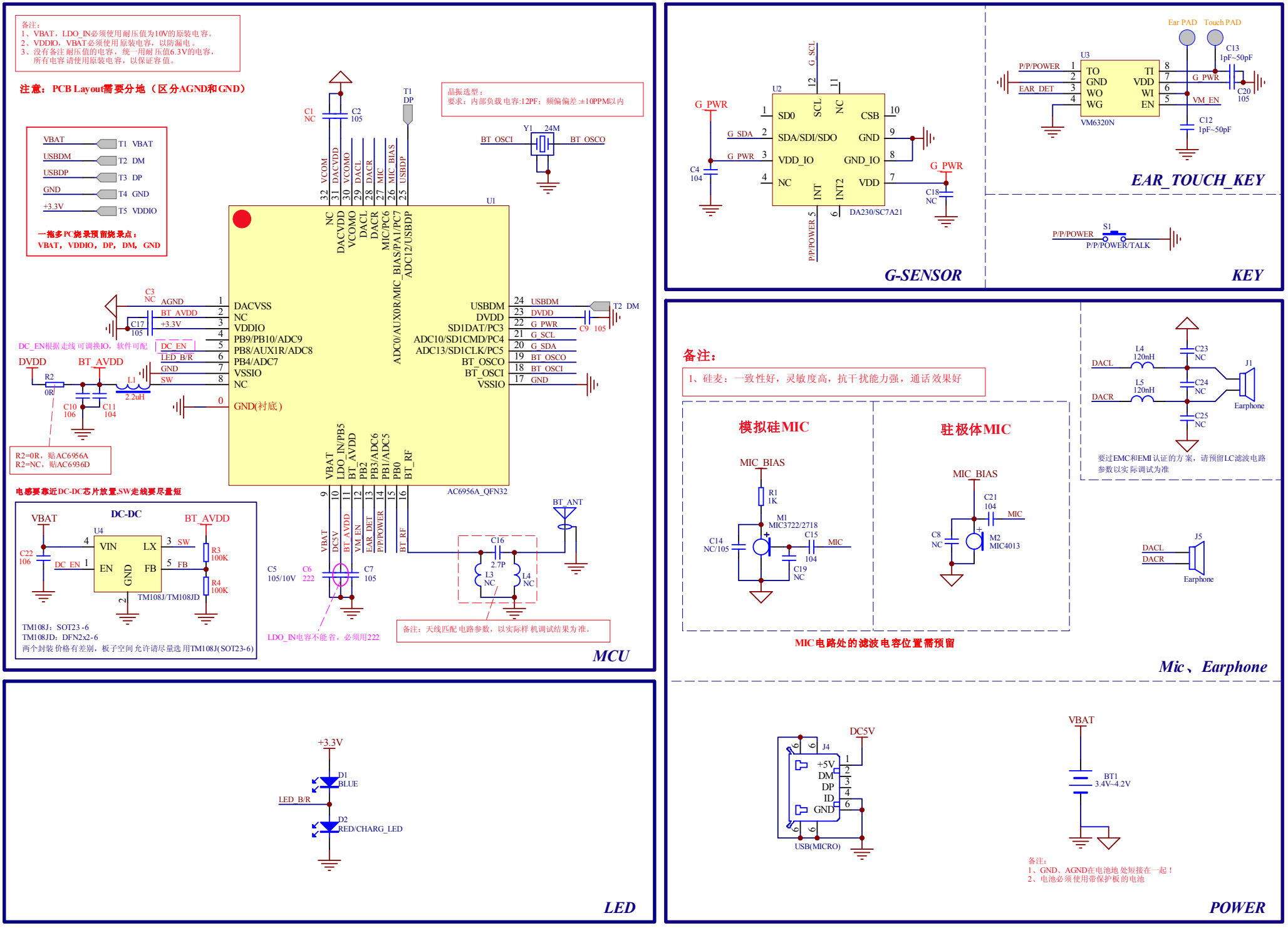

备注：
1、VBAT，LDO_IN必须使用耐压值为10V的原装电容。
2、VDDIO，VBAT必须使用原装电容，以防漏电。
3、没有备注 耐压值的电容，统一用耐压值6.3V的电容，
所有电容 请使用原装电容，以保证容值。
注意：PCB Layout需要分地（区分AGND和GND）
VBAT T1 VBAT
USBDM T2 DM
USBDP T3 DP
GND T4 GND
+3.3V T5 VDDIO
一拖多PC烧录预留烧录点：
VBAT，VDDIO，DP，DM，GND
晶振选型：
要求：内部负载电容:12PF；频偏偏差±10PPM以内
Y1 24M
BT_OSCI
BT_OSCO
U1
DACVSS
NC
VDDIO
PB9/PB10/ADC9
PB8/AUX1R/ADC8
PB4/ADC7
VSSIO
NC
GND(衬底)
USBDM
DVDD
SD1DAT/PC3
ADC10/SD1CMD/PC4
ADC13/SD1CLK/PC5
BT_OSCO
BT_OSCI
VSSIO
ADC0/AUX0R/MIC_BIAS/PA1/PC7
ADC12/USBDP
VBAT
LDO_IN/PB5
BT_AVDD
PB2
PB3/ADC6
PB1/ADC5
PB0
BT_RF
AC6956A_QFN32
DC_EN根据走线 可调换IO，软件可配
R2=0R，贴AC6956A
R2=NC，贴AC6936D
电感要靠近DC-DC芯片放置,SW走线要尽量短
DC-DC
TM108J/TM108JD
TM108J：SOT23-6
TM108JD：DFN2x2-6
两个封装 价格有差别，板子空间 允许请尽量选 用TM108J(SOT23-6)
LDO_IN电容不能省，必须用222
备注：天线匹配 电路参数，以实际样 机调试结果为准。
MCU
G_SCL
G_SDA
G_PWR
SD0
SDA/SDI/SDO
VDD_IO
NC
CSB
GND
GND_IO
VDD
INT
INT2
P/P/POWER
DA230/SC7A21
G-SENSOR
Ear PAD
Touch PAD
P/P/POWER
EAR_DET
TO
GND
WO
WG
TI
VDD
WI
EN
VM6320N
VM_EN
P/P/POWER/TALK
KEY
EAR_TOUCH_KEY
备注：
1、硅麦：一致性好，灵敏度高，抗干扰能力强，通话效果好
模拟硅MIC
MIC_BIAS
M1
MIC3722/2718
驻极体MIC
M2
MIC4013
MIC电路处的滤波电容位置需预留
DACL
DACR
Earphone
要过EMC和EMI认证的方 案，请预留LC滤波电路
参数以实 际调试为准
Mic、Earphone
+3.3V
D1
BLUE
LED_B/R
D2
RED/CHARG_LED
LED
DC5V
+5V
DM
DP
ID
GND
USB(MICRO)
VBAT
BT1
3.4V~4.2V
备注：
1、GND、AGND在电池地 处短接在一起！
2、电池必须 使用带保护板 的电池
POWER